P.0857.U

PROJECTION OPTICAL DEVICE

Patent number:

JP62058624

Publication date:

1987-03-14

Inventor:

MURAKAMI MASAKAZU; others: 02

Applicant:

NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international;

H01L21/30; G03F9/00; H01L21/68

- european;

Application numbers

JP19850197696 19850909

Priority number(s):

Report a data error here

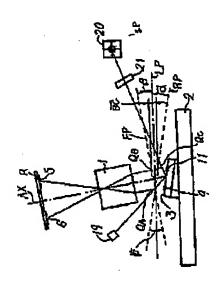
Also published as:

网 US4704020 (A1)

Abstract of JP62058624

PURPOSE:To measure the relative gradient successfully regardless of the gradient optical axis of projection lens by a method wherein the relative gradient between the wafer surface and the projection image-formed surface of a mask pattern is calibrated making reference to the gradient of projected substrate surface to the specified reference surface.

CONSTITUTION: In order to make the surface (mirror face) 3 of semiconductor wafer and the projection image-formed surface FR of a mask pattern relatively gradient, the parallel light flux from a light emitting system 19 is reflected on the mirror face 3 to be entered into a light receiving system 20. At this time, a plane parallel 21 is adjusted so that a spot SP may be image-formed on a specified position. Next a stage 2 is lifted to maximize the contrast between masks 9 and 11 for measuring the shifting amount. Finally the relative gradient between the projection imageformed surface and the wafer surface can be measured making reference to the shifting amount, the distance between masks 9 and 11 and the adjusted value of plane parallel 21.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-58624

@Int_Cl. 1

識別記号

广内整理番号

母公開 昭和62年(1987)3月14日

H 01 L G 03 F 21/30 9/00 H 01 L 21/68 Z-7376-5F 7124-2H 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

り発明の名称 投影光学裝置

> 願 昭60-197696 创特

昭60(1985)9月9日 23出

村 上 明 者 母発

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

訪 恭 諏 伊発 眀 者

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

②発 明者 J۱L 井

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 寒

社大井製作所内

日本光学工業株式会社 の出 願 人

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

外2名 正年 弁理士 佐藤 20代 理 人

ПЯ

1. 発明の名称

投影光学装置

2. 特許期求の範囲

マスクのパターンを投影光学系を介してステー ひ上の彼投影延坂に投影する場合に、鉄投影光学 系の結准面に対する破役能差板の傾きを較正する 投彫光学装盤において、

前記投影光学を介して、前記被投影莚板の数面 と前記パターンの投影紡像石との相対的な似き量 を検出する第1の検出手段と、

加記投影光学系とは無関係に、所定の転進平面 に対する彼拉彫態板の表面の傾き量を検出する第 2の輸出手段と、

前記節1の検出手段によって検出された似き無 を、前記成2の検出手段の校正情報として導入す る数正手段とを具備することを特徴とする奴略光 学装置。

3 . 発明の詳細な説明

. (殖明の技術分野)

米鉛明は、例えば呉魏爾斯などの半導体装置の 製造工程において、半導体ウェハの変面と露光な とのための投影光報との傾きの絶対角を計詞する 装置にかかるものであり、値の傾斜相対角固定系 のキャリプレーション手段として好遊な投影光学 益数に関するものである。

(范阴の俘集)

従来のレベル計詞方法としては、例えば特闘昭 58-118106号に四分されたものがある。 この公報に関示された方法は、オコアキシスで平 行光束を試料 耐すなわち半導体ウェハ表面に 厭財 するというウェハ筋奴斜測定方式である。

としおが、この方式では、遊枠傾き角すなわち センサ出力が零になる傾斜角を見出すために、ク エハ面の板をを変えながらウェハに対する雪光で 行っては調整を行うという繰り返し作業が必要で

また、一度装型傾き角が決定されると、以後の 投船光輪と調定系の変化については、再びウェハ に対する忽光を行わなければならず、非常に不便

特閒昭62-58624 (2)

であり、オファキシスで平行光東を試料面に限射 する方法を有効に活用し得る手段が製設されてい る。

また、一方においてTTLによるオートレベリングと称きれるレベル細定方法もある。この方法は、猛光双野内の4ヶ所でレチクルマークのコントラストの最大はで受る面を最近結像面としてチャブレベリングを行うものであり、脚定波長と弦光波長のキャリプレーションいわゆる似斜角絶対視正方法も過気されている。

しかしながら、以上のような手段においては、 次のような不都合がある。

の4点でしかコントラストが別定されないため、 面全体の傾きを必ずしも代表していない。

②レチクルマークがウェハ頭回路に投影されると、下地凹凸の影響を受けやすく、これを避ける必要がある。

(発明の目的)・

本苑明はかがる点に鑑みてなされたものであり、

に、光学系 4 A A A B は レチ クル R 上 の 四 口 5 , 6 を 介 し て ウェ ハステーシ 2 を 観察 する と が で きる ように 配 暇 されている。 なお、 図 の 必 函 で の で な が 配 酸 されている。 またいる。 またいる。 またいる。 またいる。 またいる。 またいる の 変 面 で さん は 数 置の アライメン 飲 け られて び 放 で で の 変 面 で っ ス の 彼 正 する た め に 使 用 される 遮 極 マーク 板 の 変 面 (クロム 面) が 用 い られた 要 準 マーク 板 の 変 面 (クロム 面) が 用 い られ な 。 尚、 年 の 申 心 R C を 原 点 する ェ y 座 標 系 を を い た と き、 夫々、 x 始、 y 動 上 に 配 図 される。

レチクルR上の回口5,6には第4回に示すような格子状のパターンが形成されており、仰方、便前3上にはウェハスターひ2が所定の位置に来たときに、第5回に示す如くレチクルRの明口5内に来る格子状のパターン 8が形成されている。また、かかる位置にウェハステージ2があるときには、他の阴口6,7,8についても第5回と同様の状態となるように併子状のパターン 10,

投影レンズの光軸の傾きにかかわらず、良好に半 写体ウェハの表面の傾きを袖正あるいは使正する ことができる投影光学英型を提供するととをその 目的とするものである。

(成明の低要)

本が明は、第1の佼出手段により、被役影勘板例えば半導体ウェへの要面とマスクのバタ・シの役別を登せる役別光学系を介して校出し、第2の佼出手段により、所定の遊れでは対する被投影器板の表面の模さ是を投影光学系とは解関係に検出し、第1の校出手段による機ととは解関係に検出手段の較正常なとしている。

(爽施例)

以下、本発明にかかる投身光学装置を、添付図面に示す変旋例を容開しながら詳細に説明する。

第2 図には、本発明の変態例において使用される 28 光装 図の接頭の構成が示されている。この図において、例えば第3 図に示すようなレチクル R は、投影レンズ 1 の物体側に配置されており、更

梦照)。

第7 図において、原明光は光ファイバー14によって図示しない光気から導かれており、ハーフミラー30 及び反射ミラー32 を介してレチクルRの関口5 の方向に送られている。ハーフミラー30 と光ファイバー14 との間の適宜位置には、
断射視野紋り13 が設けられており、レチクルR

特別昭62-58624 (3)

団像信号を読み込む場合は、逆面 & 上のマーク B のみの像のコントラストを検出することになる。

関に、総 8 図、館 6 図に示すように、レチクル R 周辺の複数のマークないし明口 5 , 6 , 7 , 8 の格子パクーンは、各々設けられたアライメント 光学系でステージ 2 を動かすことなく回時にレージ 2 を光学系の下に設置 3 上のマーク 8 , 1 0 , 1 2 がくるように移動させたとし、ステージ 2 の走りや額面 3 を保存するホルダー 等が 質到してしまった場合に測定の思味がなくなか 5 である。第 5 図の領域 a , 8 はどちらを用いるようにしてもとい。

ことで、投影レンズ1の結像光粒AXは、ステージ2の水平な走り前に対して角度を低いており、 技面3は角度で横いているものとする。窓1図に は、かかる場合が示されている。この図において、 レチクルRの結復而をドP、ステージ2の水平な 足り而をLPとすると、角度βは結像所ドPと定 り面1Pとの傾き角でもある。さらにこの図にお ピカメラ 1 5 の解像力に近い緑幅に激定されている。以上の操作により、レチクルRと工楽用テレビカメラ 1 5 の数像節との合為が行われる。

次に、鏡面3上のマーク9を回様の処理で、説面3を上下動させて合然する。との操作により、工業用テレビカメラ15の機像面、レチクルR、及び親面3の合体が行われることとなる。すなわち、工業用ナレビカメラ13は、第5図の領域4,6のいずれのマーク像も最良のコントラストで優像できることとなる。なお、コントラスト校出は、例えば特別昭60-101540号に関示された方法で行う。

また、上記試験において、領域ので極級する合金には、レチクルR上のマークないし関ロ5内の格子スターンを選回すなわち技器レンズ1何から逆照明することになる。投影レンズ1がレチクルR側で非テレセントリックであるとすると、格子スターンからの直接反射光はテレビ系に戻らず、西面内で級く見えることとなる。他方、領域とで

いて、送光系18及び受光系20により待開昭58-113706号公報に開示されたようなオートペリングセンサが構成されており、受光系20とメタージ2との間の光路中には零点補正機構21が配置されている。送光系19はウェハに強布されたフォトレジストを感光させない波長の光を射出する。

特開昭62-58624 (4)

B の方向に光束がシットする。従って、プレーンパラレル 2 1 A , 2 1 B の双方の頃 B を適当に調整するととにより、 2 次元的に光束をシットをせることができる。

次に、第9回(D)に示すように、受光系20 は受光染子20A,20日,20C,20Dから 成っており、各々アンプ20E,20F,20G, 20日を介して処理菌路201に投税されている。 前述したように、電点補正機構21を透過した光 は、受光系20のほぼ中心部にスポットを形成す るように入射するが、受光素子20A,20B, 20℃、200の出力数から入射光束のスポット のシフトの程度が2次元的に検出できるようにな っている。勿論、交光系20は、疫両3やウェハ 影声の値をを検出するものでもある。特別M 5 8 一 1 18106分にも明示されているように、送 光系18は、投影レンメ1による欧光領域の会体 に斜めから平行光束を照射するものであり、受光 系20上のスポットの位置変化は、露光微域全体 の平均的な面の傾きを代表したものとなる。

Dが (A+D) ー (B+C) = 0 となるようにする。この調整後の状態はあ1 0 図 (B) に示す通りである。次に、プレーンパラレル 2 1 人の傾斜を調整して、 (A+B) ー (C+B) = 0 となるようにする。これによって容点補正が行われる。なお、このときのプレーンパラレル 2 1 A, 2 1 Bの倒き最ないし角度は、初期値として紹復される。

次に、第1回において、図示しないセンサ手段により位置を測定しつつスタージをを上昇させ、
20回3上のマーク9のコントラストが最大となるようにする。この調整には、第1回に示す後望が利用される。との点をQ人とすると、マーク9に対向するマーク11の位置はQCとなる。ここで、 類面3は走り面LPに対して傾いているものとし、 技面3と平行で点Q人を含む面をRPとする。そ

次に、更にステージでを上昇させると、位配 QBにおいてマーク 1 1 のコントラストが最大となる。このときのステージでの走り面しPと頭直 方向の移動品から上下動かした距離BC(位置 尚、プレーンパラレル21A,21Bは、失保は平行光路中に存在するのではなく、ウェハや鏡面3からの反射平行光を仰光するレンズと、そのレンズによる無点面に配置された受光系20との隣に存在する。また処理回路201は、プレーンパラレル21A,21Bを回転するための原動を一夕に透宜倒御信号を出力する。

次に、上記変施例の全体的動作について説明する。 節1 図において、送光系 1 9 から出力された 平行光束は競函 3 によって反射されて受光系 2 0 に入射するが、とのとき、受光系 2 0 の受光電子 2 0 A, 2 0 B, 2 0 C, 2 0 Dの出力が同一と なるように関数する。

これを 部 1 0 図を 参照して 説明すると、まず、 説両 3 を レベリングセンナで 検出できるようにステージ 2 を位置決めした 時点で、 周図 (A) に示すように スポット S P が 受光系 2 0 上に 位置する ものとする。

次に、プレーンパラレル 2 1 B の傾斜を開發して受光套子 2 0 A ないし 2 0 D の出力 A 、B 、C 、

Q B , Q C 関の 能離) が求められる。 との移動量は、不図示の計測器 (エンコーダ又は無点検出系)によって検出される。一方、設計時のデータからマーク 9 と i 1 の走り 両LPに沿った方向の距離は既知である。 これをしとすると、

$$\operatorname{tra} \Psi = \frac{\mathsf{B} \ \mathsf{C}}{\mathsf{L}} \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad \mathsf{(I)}$$

となる。しかし、支際には

と近似することができる。

次に、第1図に示すように、超面3の位配を下げて送光系19の光が再び受光系20に入射するようにする。このとを、受光系20は、第10回 (C)に示す状態となっているはずである。

特開昭62-58624 (5)

そして、

に相当する方向すなわち- (α+β) の万向から 光が入射した場合と同様の出力が受光系20によ って得られるように、零点相正機構21を調整す る。すなわち、容点の状態にある受光系20に対 し、第3式で示すオフセットをかけることとする。 なお、受光系20の出力と零点補正機構21のプ レーンパラレル21A,21日の回転角皮との関 係は、あらかじめ処理国路201内にテーブルと して求められており、これを利用して上能調整が 行われる。

次に、ゥェハ面すなわち興面3が原面でなわち 第1図の点QA,QBを含む面FPと一致するよ うにステージを全不図示のレベリング調整機構を 用いて創御する。前述した調整により、既(3)式で **示すオフセットがすでにかけられているので、**精 **依陌ドPと娘前8が平行になるようにステージ2**

対してわずかに低いていた場合、レチクル凡の明 ロ5, 6, 7, Bの投影像が結像する原面も、光 粒AXとは亜瓦にはならず、わずかに似いてしま う。しかし、そのような場合であっても、レチク ルRの投影像面とウェハ表面とが平行になったと き、受光派20は零点になるように設定される。

さて上記例では、2つのマーク9,10を用い た場合を説明したが、とれる8次元に拡駆しても 阿様である。平面の傾きないし角度は、平面との ま点の位置関係から来ゆることができる。

例えば、第11四に示すように、TTレフォー カス計削 (第1 図参照) の対象となる原南 8 上の マークを9、10、11とし、オファキレスのオ ートレペリングセンサの光軸も30とする。郑 11 國で座標系XYの原点は投影レンズ1の光鞘 AXと交わり、円形の領域はイメージフィールド である。この光軸30に対する角度オフセットは、 一般的には2方向例えば動な。7によツ、7ツと して与えられる。なお、よ、7は、交光系20上 における座鉄軸である(第10回(C)を照)。

の姿勢を調整すれば、交光系20が零点の状態と なる。

すなわち、受光系祭子20A,20B,20C, 2 0 Dの出力が等しくなるようにする。

別言すると、第2の放出手段としての受光系 20は、虚初まずステージで上の位面をによって [0] の状態にセットされ、次に、第1の検出手 取としてのTTLアライメント光学系4A,4B、 ステージ2の上下量の計簿器によって樹料角Ψ (BC/L) を検出し、その逆方向の傾き舟 (-BC/L) のオフセットを校正手段としての プレーンパラレル21A,21Bの回転角に較正 位として導入するようにする。

このようにすると、鏡面3が走り而LPに対し て傾いたとしても、受光系20は結婚面FPと平 行な面を指に零点として検出するように較正され る。また、第1回ではレチクル凡が光軸人又と型 近になり、柏像面FPも光軸AXと趣催になるよ うに示したが、このような設定は必ずしも必要な ことではない。すなわちレチタルRが光額AXに

加定するマークタ、10、11によって作られ る平面から例えばX軸を中心とする傾きΨェとY 軸を中心とする似きΨッが次められる。とれらの 低きVェ、Vyをょ、 7 面に投影するには、例え ば角度変換の一般式を用いる。

以上のようにして、実際の繋光時に於けるウェ 八上の露光領域の傾きは、キャリプレーションだ れたマートレペリングセンサ(第2の伏出手収) のみによって校出し、ステージ2の姿勢を調整す ればまい。

また、上記例では、一頼のオートレベリングセ ンサを用いたが、抑18回に示すように、エアー 等の多点烈走非TTL万式を第2の検出手段とし て用いるようにしても、オートテップレベリング における箱対値キャリプレーション等を両機に行 うととができる。

が述すると、郡12図(A)に示すように、设 **彫レン式100の周囲に、エアマイクロ式オート** フォーカス校出部102,104,108を設け る。これらの放出部102、104、108は、

特開昭62-58624 (6)

従って、個々のセンサに対し、産当なオフセットを加えることによりキャリプレーションを行う ことができる。

は平行していることになる。

更に、上記夫施例では、平行平面ガラスを回転 させて数正を行うようにしたが、以下のような方

(発明の効果)

以上のように、本苑別によれば、投影光学系による投影像面の傾きの有無にかかわらず、良好に半導体ウェハの製面の概をを補正することができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本苑朝の一変施例における前正時の 状態を示す説明図、第2図はでTL光学系の一段略 構成を示す説明図、第3図はレチクルRの一のの 示す平面図、第4図はレチクルRに形成され でつから見た状態を示す説明図、第6図はレチクル 明白から見た状態を示す説明図、第6図は変のの 一列を示す平面図、第8図はエ発用をレビののの を示すすっク図、第8図はエ発用をレビはまっ を示すする。第9図はエ教明の もいれたのの もいれたのの を示すする。第9図はエ教明の もいれています。 11図及び第12図は本范朝の他の実施例を示す は明図である。

主要部分の符号の説明

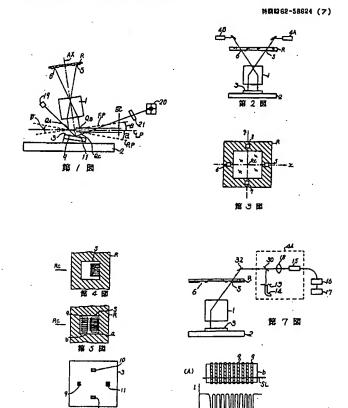
Ⅰ…投影レンズ、2…ステーツ、3…競而、4…

次で較正を行うようにしてもよい。

那1の方法は、まずTTTL方式によって角段を とっとの合成角が検出されたときに、斜めから光 が入射しているレベリングセンサの出力するを 受光系20の出力を配慮し、次に、被記憶値を、 フェハ面のレベリング計画時の 正確値とする。 に、電気的又はソフトウェア的に換算する。 に、 場合には、実際にウェハ面を計測したときのの リングセンサ受光系20の出力と記憶値とが同一 のときに結像面とワェハ面とが一数することにな る。

いずれの突旋例においても、放面は基準マーク 板であり、ウェハをチャックするホルダーの駆促 面とは伊平行にステージ上に取けられ、競面とホ ルダーの戦型面とは完全に平行である必要はない。

代理人 介理士 佐 陳 正 年



-149-

